

4.- PROPIEDADES ELÉCTRICAS DE LOS SÓLIDOS



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

TISICA DEL ESTADO SOLIDO II

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.



4. Propiedades eléctricas de los sólidos

- Semiconductores extrínsecos.
- Dieléctricos.
- Ferroelectricidad.
- Piezoelectricidad.



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70 ---ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.













www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.



TABLE 18-7 The donor and acceptor energy gaps (in electron volts) when silicon and germanium semiconductors are doped

Dopant	Silicon		Germanium	
	E _d	Ea	E _d	Ea
Р	0.045		0.0120	
As	0.049		0.0127	
Sb	0.039		0.0096	
В		0.045		0.0104
AI		0.057		0.0102
Ga		0.065		0.0108
In		0.160		0.0112

Niveles de energía introducidos por



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganosio saber y será retirada.



Cartagena99

Semiconductores Extrínsecos



Densidad de estados, función de Fermi y áreas representando la concentración de electrones y huecos para el caso en el que la Energía de Fermi está por debajo del nivel intrínseco.



ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganosio saber y será retirada.



Cartagena99

Semiconductores Extrínsecos



Posición del nivel de Fermi en función de la concentración de donores (tipo n) y aceptores (tipo p)



Posición del nivel de Fermi en función



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganosio saber y será retirada.





Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganosio saber y será retirada.



$$n = N_{c} \exp\left[-\frac{(E_{c} - E_{F})}{kT}\right] = n_{i} \exp\left[-\frac{(E_{F} - E_{Fi})}{kT}\right]$$
$$\Rightarrow n \cdot p = n_{i}^{2}$$
$$p = N_{V} \exp\left[-\frac{(E_{F} - E_{V})}{kT}\right] = n_{i} \exp\left[-\frac{(E_{F} - E_{Fi})}{kT}\right]$$

En un semiconductor extrínseco $n \neq p$ pero en todo caso $n \cdot p = n_i^2$



CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70 ---ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero haganosio saber y será retirada.





www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.

Semiconductores Extrínsecos (Degeneración)

Diagramas de bandas simplificados para (a) semiconductor tipo n degenerado y (b) semiconductor tipo p degenerado



Si la concentración de impurezas es muy alta, la distancia entre ellas decrece hasta tal punto que interaccionan entre ellas. Cuando esto ocurre los niveles discretos de las impurezas comienzan a



NIVERSIDA

CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TECNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.

Semiconductores Extrínsecos (Compensación)



NIVERSIDAD

Diagrama de bandas de energía de un semiconductor compensado mostrando donores y aceptores ionizados V no ionizados.

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70 **PROPIEDADES ELÉCTRICAS**

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganosió saber y será retirada.



e

Un campo eléctrico aplicado a un semiconductor produce una fuerza sobre los portadores de carga causándoles una aceleración. Este movimiento de carga debido a un campo eléctrico se llama densidad de corriente de deriva ("drift current density")

$$\overrightarrow{J_{drift}} = \rho \overrightarrow{v_d} \quad \begin{cases} \rho = Densidad \ de \ corriente \\ v_d = velocidad \ deriva \end{cases}$$

Si la velocidad de deriva es causada por un campo eléctrico:

$$\overrightarrow{v_d} = \mu_{portadores} \vec{E}$$
lectrones $\rightarrow \overrightarrow{J_{drift}} = -en\overrightarrow{v_d} = -en(-\mu_n\vec{E}) = en\mu_n\vec{E}$
huecos $\rightarrow \overrightarrow{J_{drift}} = ep\overrightarrow{v_d} = ep(\mu_p\vec{E}) = ep\mu_p\vec{E}$

$$\Rightarrow \overrightarrow{J_{drift}} = e(n\mu_n + p\mu_p)\vec{E}$$
CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE
LLAMA O ENVIA WHATSAPP: 689 45 44 70
ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS
CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganosio saber y será retirada.





Cartagena99

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.



También puede existir una corriente eléctrica por la existencia de un gradiente de concentración de portadores.



El flujo neto de portadores a través de x=0 será:

$$F_n = -v_{th} l \frac{dn}{dx} \Rightarrow J_{Diff} = -eF_n = eD_n \frac{dn}{dx}$$

Donde D_n se denomina Coeficiente de Difusión

 $D_n = l v_{th}$

Concentración de portadores vs. Distancia.Hemos de suponer que l es menor que el recorrido libre



r que l b libre $J_{Diff} = eD_n \frac{dn}{dx}$ para electrones CLASES PARTICULARES, TUTORIAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.



La corriente total será la suma total de cada una de las corrientes atendiendo al signo correspondiente.



www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganosio saber y será retirada.



Conductividad Iónica



- ✓ Conduction in Ionic Materials Conduction in ionic materials often occurs by movement of entire ions, since the energy gap is too large for electrons to enter the conduction band. Therefore, most ionic materials behave as insulators.
- ✓ **Conduction in Polymers** Because their valence electrons are involved in covalent bonding, polymers have a band structure with a large energy gap, leading to low-electrical conductivity.

agena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al 17.1 de la Lev de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio El Si la información contenida en el documento es ilicita o lesiona bienes o derechos de un tercero haganosio saber y sera retirada.



WWW.C

Conductividad Iónica



Coeficiente de difusión D como función del recíproco de la temperatura para alguno metales y cerámicas.

En el gráfico de Arrhenius, D representa la velocidad del proceso de difusión. Una pendiente pronunciada denota una energía de activación alta.

En un conductor iónico, la movilidad viene dada por:

 $\mu = \frac{qD}{kT}$

hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al icita o lesiona bienes o derechos de un tercero hadanosio saber y sera retirada.

PROPIEDADES ELÉCTRICAS

 $\begin{cases} q = Carga \ del \ ión \\ D = coef \ difusión \\ NICAS ONLINE \end{cases}$





CLASES PARTICULARES, TUTORÍAS TÉCNICAS ONLINE LLAMA O ENVÍA WHATSAPP: 689 45 44 70

ONLINE PRIVATE LESSONS FOR SCIENCE STUDENTS CALL OR WHATSAPP:689 45 44 70

www.cartagena99.com no se hace responsable de la información contenida en el presente documento en virtud al Artículo 17.1 de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y de Comercio Electrónico, de 11 de julio de 2002. Si la información contenida en el documento es ilícita o lesiona bienes o derechos de un tercero háganoslo saber y será retirada.